

A1 2013 前期
ミューオンの寿命測定・ g 因子の測定

木村 燎平 佐伯 一帆 高木 亮一 向井 大智 山本 修平

1 実験の目的

陽子や He を主成分とする宇宙線 (一次宇宙線) が地球大気内で崩壊することで生じる宇宙線 (二次宇宙線) の中でも地表で安定して測定可能である μ 粒子の寿命を測定する。さらに、 μ 粒子のスピン角運動量とそれによる磁気モーメントを関係付ける g 因子を測定する。

2 理論

$c = \hbar = 1$ の単位系を用いる。

2.1 ミューオンの崩壊

大気圏内で生成された μ 粒子は 2 種類あり、次の式に従い崩壊する。

$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \quad (1)$$

$$\mu^- \rightarrow e^- + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \quad (2)$$

μ^- は負電荷を持ち、物質中 (この実験では銅) の原子核に捕獲され、K 殻の電子と入れ替わることでミューオン原子を作る。この時

$$\mu^- + p \rightarrow \nu_\mu + n \quad (3)$$

という反応で μ^- が吸収され、見かけ上寿命が短くなる。この変化は粒子を受け止める物質によって異なり、今回の測定で用いる銅では、 $\tau = 0.16 \mu s$ 程度になる。

2.2 非相対論的 Dirac 方程式と g 因子

スピン 1/2、電荷 q の粒子の g 因子を非相対論的近似で求める。電磁場 $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ 中の粒子 (電荷 q 、質量 m) に対する Dirac 方程式は次で与えられる。

$$(\gamma^\mu (p_\mu - qA_\mu) - m)\psi = 0 \quad (4)$$

ただし、 γ^μ は Dirac のガンマ行列で、ここでは Dirac-Pauli 表現

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

を用いる。 I は 2×2 の単位行列、 $\gamma^i (i = 1, 2, 3)$ は Pauli 行列の第 i 成分である。 ψ を二成分スピノール $\begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \end{pmatrix}$ で分解し、非相対論近似 ($E \simeq m$) と弱い場 ($|q\phi| \ll m$) を考慮

$$E + m - q\phi \simeq 2m \quad (6)$$

すると、 ψ_B を消去することで

$$\left(\frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A}))^2}{2m} + q\phi + m \right) \psi_A = E \psi_A \quad (7)$$

となる。また、 $\mathbf{p} = -i\nabla$ より、演算子として

$$\mathbf{p} \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \mathbf{p} = -i\nabla \times \mathbf{A} = -i\mathbf{B} \quad (8)$$

が成り立つので、結局、

$$\left(\frac{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2}{2m} - \frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} + q\phi + m\right)\psi_A = E\psi_A \quad (9)$$

となる。これより、スピン 1/2 の粒子は磁場内で磁気モーメント

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} = g\frac{q}{2m}\mathbf{S} \quad (10)$$

を持ち、非相対論的近似では g 因子が 2 であることがわかる。

2.3 スピンの歳差運動

粒子の持つスピンによる磁気モーメントが外部磁場の影響で歳差運動を起こすことを見ていく。

磁場とスピンの相互作用の Hamiltonian は (6) 式より

$$\hat{\mathcal{H}} = -g\frac{q}{2m}\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B} \quad (11)$$

で与えられる。磁場の方向に z 軸をとると ($\mathbf{B} = (0, 0, B)$)、

$$\hat{\mathcal{H}} = -g\frac{q}{2m}\hat{S}_z B \equiv \omega\hat{S}_z \quad (12)$$

となる。これより、時刻 t のスピン状態ベクトルを $|\varphi(t)\rangle$ としてスピンの各方向の期待値 $\langle S_i(t) \rangle$ は、時間発展演算子 $\exp(-i\hat{\mathcal{H}}t)$ を用いて、

$$\langle \varphi(t) | \hat{S}_i | \varphi(t) \rangle = \langle \varphi(0) | e^{i\hat{\mathcal{H}}t} \hat{S}_i e^{-i\hat{\mathcal{H}}t} | \varphi(0) \rangle \quad (13)$$

となる ($i=1,2,3$)。 z 成分については、時間発展演算子とスピン演算子が可換なので

$$\langle S_z(t) \rangle = \langle S_z(0) \rangle \quad (14)$$

となり、時間依存しない。 x 成分については、スピン各成分の交換関係

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = \epsilon_{ijk} i\hat{S}_k \quad (15)$$

と Baker-Hausdorff の補助定理

$$e^{\hat{A}t} \hat{B} e^{-\hat{A}t} = \hat{B} + t[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{t^2}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots \quad (16)$$

を用いて

$$\begin{aligned} \langle S_x(t) \rangle &= \langle \varphi(0) | e^{i\omega\hat{S}_z t} \hat{S}_x e^{-i\omega\hat{S}_z t} | \varphi(0) \rangle \\ &= \langle \varphi(0) | \hat{S}_x + i\omega t[\hat{S}_z, \hat{S}_x] + \frac{(i\omega t)^2}{2!}[\hat{S}_z, [\hat{S}_z, \hat{S}_x]] + \dots | \varphi(0) \rangle \\ &= \langle S_x(0) \rangle \cos \omega t - \langle S_y(0) \rangle \sin \omega t \end{aligned} \quad (17)$$

となり、期待値が角振動数 ω で振動していることがわかる。 y 方向についても同様である。よって、計測により B と ω が求まれば、

$$g = \frac{2m\omega}{|q|B} \quad (18)$$

と求めることができる。

3 実験のセットアップ

3.1 セットアップ・及び実験原理

μ を検出しアナログ信号に変えるために用いた装置は以下のものからなっている。・プラスチックシンチレータ ($100 \times 48 \times 1\text{cm}$)2 枚・プラスチックシンチレータ ($50 \times 5 \times 1\text{cm}$)7 枚・光電子増倍管 (PMT)2 本・コイル (詳細は後述)1 つ・銅板 ($50 \times 48 \times 1\text{cm}$)1 つ・MPPC 及びそのための基盤 (詳細は後述)7 つ・光ファイバー 7 本以上の装置を次の図のように μ の寿命測定 (以下実験 a)、 μ の g 因子測定 (以下実験 b) それぞれ配置した。

3.1.1 実験 a

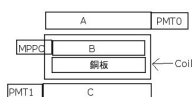


図 1 μ の寿命測定

3.1.2 実験 b

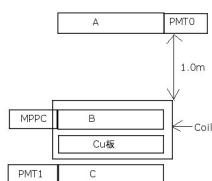


図 2 μ の g 因子測定装置

ここで、A,B,C はいずれもプラスチックシンチレータである。上記の装置で μ は、以下のような振る舞いを行う。1. μ がどこからか降って来て、A と B を突き抜け、銅板にたどり着く。2. 銅板にたどり着いた μ はエネルギーが高い場合突き抜け、C までたどり着くが、あるエネルギー程度の μ は Cu 板で止まる。3.2 で銅板で止まった μ は時間が経過すると弱い相互作用によって崩壊する。4.3 で生じた陽電子が B、または C にたどり着く。

なお、実験 a と b のそれぞれのセットアップで MPPC と PMT0 の距離を変えたのは、a では μ のカウント数をなるべく増やして統計誤差を減らすために狭く設定したが、b ではシンチレータに対してスピンの方向が垂直な向きであることを仮定しているので、あまり上のシンチレータと銅板との間隔が狭いと斜めからの μ が入り込んでしまうことも考慮して、a より広く間隔を設定した。

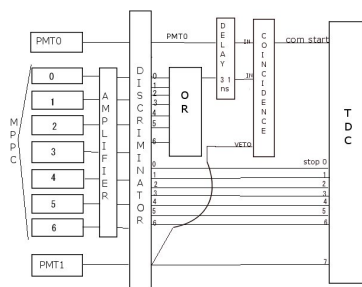


図 3 実験回路図

3.2 実験の回路図

また、この回路図で delay31ns を組んでいるのは、MPPC と PMT0、PMT1 の信号を COINCIDENCE でタイミングを合わせるためである。この回路を論理記号を用いて表すと、

- Start 信号 $(PMT0 \wedge MPPC) \rightarrow PMT1$
- Stop 信号 0 6 MPPC 0 6
- Stop 信号 7 MPPC 1

となる。

3.3 コイル

本実験の g 因子測定において、磁場をコイルから発生させた。コイルは 2004 年度 P1 の課題研究用に作成されたものを使用した。このコイルは Main コイルとして 4 つのコイルを並列でつないだものを並べ、さらに 2 つの Sub コイルを用いたものを使用した。Main コイルには 31.0V で 19.0A、sub1 コイルには 3.5V で 0.80A、sub2 コイルには 3.6V で 0.80A の電流を流した。磁場の測定では、コイルに電流を流してから 24 時

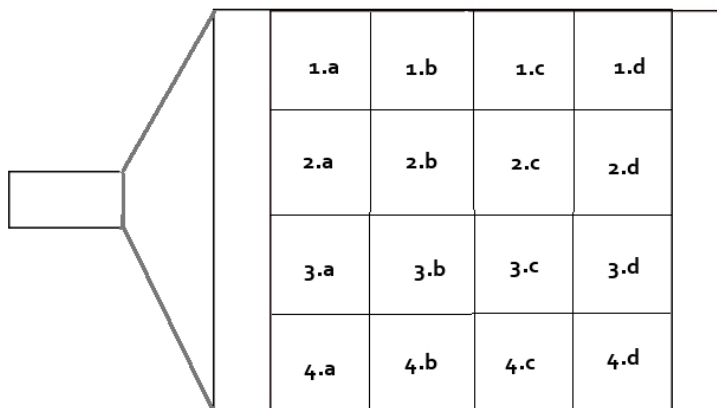


図 4 coil.tex

間経過して磁場が安定したあと、測定位置を銅板が入っている部分を銅板の大きさが縦 50cm 横 48cm なので、上図のように 16 のセクションに分け、それぞれの場所においての磁場を計 3 回測定した。その測定結果を下表に記す。

セクション	1 回目 [Gauss]	2 回目 [Gauss]	3 回目 [Gauss]	3 回の平均 [Gauss]
1.a	51.0	47.0	49.4	
1.b	53.0	50.1	53.6	
1.c	51.6	50.4	50.2	
1.d	49.6	49.7	49.6	
2.a	54.7	49.2	52.0	
2.b	55.2	49.5	50.2	
2.c	53.2	49.0	48.7	
2.d	50.2	49.8	49.9	
3.a	51.2	48.8	49.4	
3.b	50.2	48.9	49.2	
3.c	49.8	48.3	50.5	
3.d	49.6	47.7	48.9	
4.a	50.6	48.0	49.3	
4.b	49.2	49.4	49.8	
4.c	51.5	47.4	48.0	
4.d	49.8	48.4	49.3	
ave.	51.3	48.9	49.5	

この測定結果から磁場を計算すると、

3.4 TDC の較正

3.5 PMT(光電子増倍管)・及び Discriminator の設定

ここで、 μ の寿命測定及び g 因子測定で用いた PMT の電圧・及び Discriminator の設定の過程を述べる。

3.5.1 Discriminator の閾値設定

まず、本実験で用いた Discriminator の閾値の設定方法について述べる。この閾値をうまく設けることで PMT 及び MPPC からの信号のうちバックグラウンドのイベントをシャットアウトし、検出したい μ の信号のみを検出することができる。本実験では、まず最初に、まず最初に MPPC と PMT 両方の Discriminator の閾値を 30mV に設定し、他のノイズをシャットアウトできるように、また gain が揃うようにそれぞれ 1700V、1750V として測定を開始した。しかし、この測定結果のグラフを見たところ、これは Discriminator の閾値が低く、 μ 以外のバックグラウンドも検出していると判断し、Discriminator の閾値を決めるために、今度は MPPC の μ の信号をそれぞれオシロスコープで見たところ、ほぼ 60mV でそろっていたので、Discriminator の閾値を 59mV で設定しなおした。また、Stop 信号が MPPC、PMT1 それぞれにきている割合を見ると、PMT1 にほとんど信号が来ていなかったのも、これは PMT の電圧設定が低すぎて μ の信号が検出できていないことが原因と判断し、PMT の電圧設定を高くし、PMT0、PMT1 それぞれ 1949V、1998V と設定しなお

し、バックグラウンドをシャットアウトするために、Discriminator の閾値を 59mV に上げた。

4 解析

4.1 フィッティングの範囲指定

今回の測定で得られたデータを μ 粒子が崩壊してできた電子のシンチレータへの到達時間 [ns] を横軸に、各到達時間のイベント数を縦軸に示してフィッティングをするが、 μ^- は μ^+ より非常に短い寿命を持つ (1.1 参照) ことから 1000ns 以下では μ^- に対応する減衰曲線が無視できないと判断して 1000ns 以降からのデータを用いてフィッティングすることにした。

4.2 寿命の解析

このヒストグラムに対し、関数

$$F(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + B \quad (19)$$

でフィッティングを行う。ただし、 A, B は定数、 τ は寿命である。

この結果、

$$A =, B =, \tau = \quad (20)$$

を得た。

4.3 g 因子の解析

このヒストグラムに対し、関数

$$G(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) (1 + B \cos(\omega(t - t_0))) + C \quad (21)$$

でフィッティングを行う。ただし、 A, B, C は定数、 τ は寿命、 ω はスピンの歳差運動の振動数、 t_0 は初期位相を考慮した定数である。これは μ 粒子が磁場の影響で歳差運動を起こし (1.3 参照)、その結果崩壊後飛び出す電子の運動の向きが変わることを考慮した。

この結果、

$$A =, B =, C =, \tau =, \omega =, t_0 = \quad (22)$$

を得た。

5 考察

5.1 寿命について

求まった寿命 $\tau =$ は誤差の範囲で文献値と一致した。今回の測定では、「 μ^- 」の範囲のデータをカットしてフィッティングを行った。これは、 μ^- の寿命 (1.1 参照) を考慮してのことである。しかし、カットしたデータだけでフィッティングを行って出した μ^- の寿命は文献値 $0.16[\mu s]$ より短くなった。

5.2 g 因子について

5.3 反省:MPPC について

例年の測定では PMT のみを使った測定だったが、今回は PMT と MPPC とを併用した測定となった。初めての試みだったのでいくつかの反省点、今期以降使う方への留意点を上げていく。

- セッティング

MPPC はダイオードであるので、取り付ける向きを間違えると大電流が流れ、壊れる原因になってしまう。今回の測定でも一つ向きを間違えてしまったのが見つかったが、取り替えをせず向きを訂正して使用してしまった。また、素子が回路から外れやすく、遮光等のセッティングの際にも注意すべきである。

- Breakdown 電圧の調整

MPPC の型番によって Breakdown 電圧に差があり、各 MPPC に対するデータはあるにしろ、基盤によって変化してしまうこともあり揃えるのに非常に時間がかかってしまった。また、温度が上がると Breakdown 電圧が上がるという温度依存性も考慮する必要があり、細心の注意を払わなければならない。